

[illegible]

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Прочие изделия</u>		
		2		Диод Шоттки	1	VD1
				MBR130LSFT1G; 1A; 30V;		
				ф. ON Semiconductor,		
				США; корпус SOD-123.		
		3		Индуктивность	1	L1
				LQG15HS27NJ02D;		
				ф. Murata, Япония;		
				27 нГн; 5%; корпус 0402.		
				<u>Кнопочные</u>		
				<u>переключатели</u>		
		4		Переключатель	1	SA1
				KLS7-SS-12F19-G5;		
				ф. KLS, Китай.		
		5		Кнопка тактовая	4	SB1-SB4
				KLS7-TS6604-4.3-180;		
				ф. KLS, Китай.		
				<u>Конденсаторы</u>		
				<u>керамические</u>		
		6		GRM3165C1H220JD01D;	2	C5, C6
				ф. Murata, Япония;		
				22 пФ; 50 В; 10%; X7R;		
				корпус 1206.		
		7		GRM31BR72J103K;	1	C7
				ф. Murata, Япония;		
				0,01 мкФ; 50 В; 10%;		
				X7R; корпус 1206.		
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ИЧ4 ИЧ 11.03.03 09.08.00	
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата	Лист	
					2	

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		8		GRM319R71H104K;	9	СЗ,
				ф. Muraata, Япония;		С8-С10,
				0,1 мкФ; 50 В; 10%;		С12-С16
				X7R; корпус 1206.		
		9		GRM31MR71H105K;	1	С4
				ф. Muraata, Япония;		
				1 мкФ; 50 В; 10%;		
				X7R; корпус 1206.		
		10		GRM31CR71E106KA12L;	1	С11
				ф. Muraata, Япония;		
				10 мкФ; 50 В; 10%;		
				X7R; корпус 1206.		
				<u>Конденсаторы</u>		
				<u>электролитические</u>		
		11		TECAP, 0.1 мкФ, 35В,	1	С1
				тип А, 10%, Китай.		
		12		TECAP, 10 мкФ, 35В,	1	С2
				тип А, 10%, Китай.		
		13		Кварцевый резонатор	1	ZQ1
				НС-49SM-24 МГц;		
				Китай.		
				<u>Микросхемы</u>		
		14		Стабилизатор	1	DA1
				напряжения		
				MIC5201-3.3YS-0.2A;		
				корпус SOT-223;		
				ф. Microchip Technology,		
				США.		
Инв. № подл.	ИУ4 ИУ 11.03.03 09.08.00					Лист
						3
Инв. № подл.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата		

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		15		Микросхема NEO-6M; ф. U-Blox, Швейцария	1	DD1
		16		Микросхема STM32F100C8T6B; ф. ST Microelectronics, Швейцария; корпус LQFP-48.	1	DD2
				<u>Разъемы</u>		
		17		Клеммник KLS2-125-3.81-02P; ф. KLS, Китай.	1	XS1
		18		Разъем U. FL-R-SMT-1; ф. Hirose Electric, Япония.	1	XS2
		19		Гнездо на плату 2,54мм 1x4 прямое PBS-4; ф. Ningbo connfly electronic, Китай.	1	XS3
		20		Гнездо на плату 2,54мм 1x4 прямое PBS-8; ф. Ningbo connfly electronic, Китай.	1	XS4
				<u>Резисторы</u>		
		21		RC1206FR-0710RL; 0,25 Вт; 10 Ом; ±1%; корпус 1206; Тайвань.	1	R3
		22		RC1206FR-0710KL; 0,25 Вт; 10 кОм; ±1%; корпус 1206; Тайвань.	1	R4-R8
ИЧ4 ИЧ 11.03.03 09.08.00						
ИЧ4 ИЧ 11.03.03 09.08.00						
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата	Лист	
					4	

[illegible][illegible]

ИУ4 ИУ 11.03.03 09.08.00

Лист

5